### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11211999 A

(43) Date of publication of application: 06.08.1999

(51) Int. CI

G02B 26/02

G09F 9/30

(21) Application number:

10015520

(71) Applicant:

**TEIJIN LTD** 

(22) Date of filing:

28.01.1998

(72) Inventor:

**KIN TATSUICHIRO** 

YATABE TOSHIAKI

## (54) OPTICAL MODULATING ELEMENT AND **DISPLAY DEVICE**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a novel optical modulating element and a display device for which no polarizing plate is used.

SOLUTION: This device is composed of two substrates, one of which is transparent at least, arranged while being opposed and a supporting structure for supporting both the substrates and has a cell having the void layer with thickness from 0.05 to 20  $\mu m$ and an outer means capable of changing the thickness of this void layer. Then, this optical modulating element changes the spectrum pattern of light transmitted through or reflected on the cell based on the interference effect of reflected light on two interfaces of the said void layer and both the substrates, and the display device arranges these optical modulating elements in the shape of one-dimensional array or twodimensional matrix.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-211999

(43)公開日 平成11年(1999)8月6日

(51) Int.Cl.4	識別配号	FI		
G 0 2 B 26/02		G 0 2 B	26/02	A
G09F 9/30	3 7 1	G09F	9/30	371

#### 審査請求 未開求 請求項の数6 OL (全 6 頁)

(21)出顧番号	<b>特顧平10-15520</b>	(71) 出題人 000003001
		帝人株式会社
(22)出顧日	平成10年(1998) 1月28日	大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号
		(72)発明者 金 辰一邱
		東京都日野市旭が丘4丁目3番2号 帝
		株式会社東京研究センター内
		(72)発明者 谷田郎 俊明
		東京都日野市旭が丘4丁目3番2号 帝
		株式会社東京研究センター内
		(74)代理人 弁理士 前田 鉱博
		CANTAGE STATE BOTH POLY

## (54) 【発明の名称】 光変調索子および表示装置

### (57)【要約】

【課題】 偏光板を用いない新規な光変調素子および表示装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 少なくとも一枚が透明な対向配置された二枚の基板と、両基板を支持するための支持構造とからなり、厚さが0.05~20μmの空隙層を有するセルと、該空隙層の厚みを変化させ得る外的手段とを有し、空隙層と両基板との二界面での反射光の干渉効果に基づきセルを透過もしくは反射する光のスペクトルバターンを変化させることを特徴とする光変調素子およびこれを一次元のアレー状もしくは二次元のマトリクス状に配列して表示装置。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一枚が透明な対向配置された 二枚の基板と、両基板を支持するための支持構造とから なり、厚さが0.05~20μmの空隙層を有するセル と、該空隙層の厚みを変化させ得る外的手段とを有する ことを特徴とする光変調素子。

【請求項2】 少なくとも一枚が透明な対向配置された 二枚の基板と、両基板を支持するための支持構造とから なり、厚さが0.05~20μmの空隙層を有するセル と、該空隙層の厚みを変化させ得る外的手段とを有し、 空隙層と両基板との二界面での反射光の干渉効果に基づ きセルを透過もしくは反射する光のスペクトルパターン を変化させることを特徴とする光変調素子。

【請求項3】 二枚の基板として導電性の基板を用い、 両基板に電荷を供給することにより空隙層の厚みを変化 させることを特徴とする請求項1または2記載の光変調 素子。

【請求項4】 二枚の基板として導電性の基板を用い、 外的手段として両基板に電荷を供給しうる電荷供給装置 を用いることを特徴とする請求項1または2記載の光変 20 調索子。

【請求項5】 上記セルを一次元のアレー状もしくは二 次元のマトリクス状に配列してなる表示部と、各セルの 空隙層の厚みを個別に変化させ得る外的手段を有し、各 種情報の表示を行うととを特徴とする表示装置。

【請求項6】 請求項1~4のいずれかに記載の光変調 素子を一次元のアレー状もしくは二次元のマトリクス状 **に配列してなることを特徴とする表示装置。** 

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光変調素子およびそ れを用いた表示装置に関する。かかる表示装置は光演算 処理装置や光の色を時間的に変化させることができるカ ラー照明装置等の構成部品として、もしくは各種メータ ーのインジケーター、各種コンピューター、携帯情報端 末等のモニター等の用途に好適に用いることができる。 [0002]

【従来の技術】近年パソコンその他各種機器のモニター として液晶表示装置が広く用いられるようになってきて いる。しかしながらこれらの液晶表示装置は偏光板によ 40 る光の吸収という問題があり、明るい表示が得られにく いといった問題がある。

#### [0003]

【発明の解決しようとする課題】本発明は前述した問題 点を解決するために、偏光板を用いない新規な光変調素 子および表示装置を供給することを目的とする。

## [0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、少なくとも一 枚が透明な対向配置された二枚の基板と、両基板を支持 するための支持構造とからなり、厚さが0.05~20 50 わち基板が軟質で変形しやすく支持構造が硬質で変形し

umの空隙層を有するセルと、酸空隙層の厚みを変化さ せ得る外的手段とを有し、空隙層と両基板との二界面で の反射光の干渉効果に基づきセルを透過もしくは反射す る光のスペクトルバターンを変化させることを特徴とす る光変調索子であり、更にはこのセルを一次元のアレー 状もしくは二次元のマトリクス状に配列させ、各セルの 空隙層の厚みを個別に変化させる外的手段を用いて各種 情報の表示を行う表示装置である。

【0005】本発明の光変調案子は、空隙層を有するセ 10 ルおよび該空隙層の厚みを変化させ得る外的手段とを有 する。そしてかかるセルは、対向配置された少なくとも 一枚が透明な二枚の基板と両基板を対向支持するための 支持構造とから構成される。

【0008】本発明において、空隙層は、空気もしくは 窒素、アルゴン等の不活性な気体が封入された層、もし くは真空層である事が好ましい。前述のセル構造におい てとの空隙層の厚みが非常に薄い場合には、被変調光が 自然光や蛍光ランプの照明光等であっても基板と空隙層 の二つの界面の反射光の間で強い光干渉が起こり、観測 光には光強度の極大、極小ビーク(以下干渉ピークと記 す)を有するスペクトルパターンがはっきりと観察され る。

【0007】一般に空隙層の厚みがあまり厚くなると二 つの界面反射光の光干渉性が低下してしまい、また逆に 薄すぎても光変調効率が低下するため、空隙層の厚みは およそ0.05~20μmの範囲において変化させると とが好ましい。

【0008】ところで前述の光干渉によるスペクトルバ ターンは空隙層の屈折率と厚みの条件により変化すると 30 とから、外的な手段を用いて空隙層の厚みを変化させる ことによりセルを透過もしくは反射する光のスペクトル パターンおよび色相を変化させることができ、またレー ザー光等の単一波長の光もしくは色フィルター等により 選択された特定波長領域の光の強度を変化させることが できる.

【0009】本発明の光変調素子において、空隙層の厚 みを変化させる外的手段の方法としては、たとえば直流 電源、交流電源等の電荷供給源と、トランジスタおよび トランジスタアレー等によるスイッチング回路、各種C PU、メモリー等を組み合わせてなるプログラム信号発 生装置等の電荷供給装置により、対向基板間に静電気力 や静磁気力を働かせて引力、斥力を発生させる方法、も しくはマグネット、電磁コイル、圧電素子、電歪素子、 磁歪素子、歪抵抗線等を同様の方法で駆動することによ り基板を変位させる方法、もしくは空隙層を熱的に膨 張、収縮させる方法等が挙げられる。

【0010】とれらの方法においては空隙層の厚みの変 化は基板のたわみ変形もしくは支持構造の膜厚方向の変 形およびこれらの弾性回復によってもたらされる。すな

3

にくいように設計した場合、空隙圏の厚み変化は主に基板のたわみ変形による事になりり、基板が硬質で変形したくいものを用い支持構造に軟質で変形しやすいように設計した場合には、主に支持構造の膜厚方向の厚み変化による事になる。ここで前者の基板の変形を用いる場合には支持構造はセルの周囲部分にのみ形成される事が好ましく(図1、図2に例示)、後者の支持構造の変形を用いる場合には支持構造が基板全面に適度な密度で分散形成されていることが好ましい。

【0011】尚、前者の場合には支持構造が形成された 10 部分もしくはその周囲の部分が光変調に関与しないデットスペースになる事から、これらの部分に光吸収層を形成したり、これらのデッドスペースに光が入射しないように設計したマイクロレンズ等を基板上に設けるといった方法も好ましい。

【0012】支持構造を形成する材料に関しては特に限定されないが、エラストマーを含む熱可塑性樹脂、熱硬化樹脂、紫外線硬化樹脂、セラミック材料、金属材料等各種のものが挙げられ、前述のようにセルの設計により軟質、硬質の選択が為される。これら支持構造のバターニング方法としては印刷法やホトリソグラフィー法、レーザーエッチング法、ブラズマエッチング法等の方法の適用が可能であるが、特に熱可塑性樹脂を用いる場合には、熱可塑性高分子フィルムを打ち抜いてパターンを形成した後に基板上にラミネートする方法等も用いる事ができる。尚、前述の印刷法を用いた場合、粒径のそろった真球状のシリカ、ブラスチックビーズ等のスペーサー材料をマトリクス中に分散させることにより、空隙層の厚みの微調整が可能である。

【0013】又、前述のように本発明の光変調素子は、 光変調の原理として光干渉効果を用いていることから、 より効果的な光変調を行うために光変調を行う波長域で の基板と空隙層界面の反射率をある程度高く設計するこ とが好ましい。

【0014】とのためには、例えば光学膜厚値(膜厚×屈折率)を前記波長域にあわせて適切に設定した高屈折率層を基板上に一層形成する方法を用いることができるが、さらに高い反射率を得るためには、例えば最表面層を高屈折率層として高屈折率層と低屈折率層を交互に積層する方法(図6に例示)等を用いることができる。

【0015】とのような高屈折率層としては、たとえば酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化タンタル、酸化インジウム、酸化鍋、酸化パラジウム、インジウム鍋酸化物(以下1TOと記す)等が挙げられ、低屈折率層としては酸化珪素、酸化アルミニウム等の金属酸化物層等が挙げられる。これらの層は、真空蒸着、スパッタリング、イオンブレーティング、CVD等の真空プロセスもしくはゾルゲル法等の湿式プロセス等により形成することができる。

【0016】本発明の光変調索子を構成する基板は2枚 50 た基板(図6に例示)を用いることも好ましい。

が対向に配置されている。かかる基板としてはガラス、 ブラスチック等の各種の材料を用いることができる。か かる索子を透過型として用いる場合には二枚の基板の透 明性が高いことが好ましいが、反射型として用いる場合 は観察側から見て背面側の基板(以下背面基板と記す) にはむしろ透明性の低い基板を用いることが好ましい。 【0017】とのような透明性の低い基板の例としては 例えば色ガラスのように各種色素、顔料、カーボンブラ ック等を高分子、セラミック等のパインダ中に分散した ものを成形したり、適当な基体上にコーティングしてな る光吸収性基板、アルミニウム、銀、クロム、ニッケル その他の金属を成形したり、適当な基体上にコーティン グしてなる光反射性基板、ならびに各種の光散乱性基板 等が挙げられる。尚、該索子を半透過型で用いる場合に は背面基板の光吸収性、光反射性、光散乱性を若干弱め ることにより光がある程度透過することができるように すれば良い。

【0018】またかかる素子を透過型で用いる場合には、観察側から見て表示部の背面に適当な照明装置を設けることが好ましい。このような照明装置としては一般の蛍光ランプ、エレクトロルミネセンス(EL)ランプ、LED等が挙げられるが、面状の照明が必要となる場合には面状の導光板とその端部に配置されたエッジランプおよび光拡散板等からなるバックライトシステム等も好ましく用いられる。

【0019】またかかる素子の光出射側の最表面には外部光の表面反射を防ぐ反射防止処理を行う事も好ましく行われる。このような反射防止処理としては、例えば最表面に屈折率の異なる薄膜層を積層して光干渉により反 射を減じる方法や最表面を粗面化して適度に光を散乱させる等の方法等が挙げられる。

【0020】ところで本発明の光変調素子において、光 変調方法として静電気力を利用する場合には、基板上に 蓄積する電荷量を自由にコントロールできるような電荷 蓄積可能な基板を用いる必要がある。とのため少なくと も基板は導電性を有することが好ましく、導電性の基板 もしくは導電層が表面に形成された基板が好ましく用い られる。これらの基板としてはアルミニウム、銀、クロ ム、ニッケル等の金属を成形もしくはコーティングした 基板、金属、カーボン等の導電性微粒子をバインダ中に 40 分散して成形もしくはコーティングした基板等が挙げら れるが、かかる索子においては二枚の基板のうち少なく とも一方は透明である必要があり、これにはITO層等 の透明電極層を真空蒸着、スパッタリング等の方法でコ ーティングした基板を好ましく用いることができる。 尚、前述のように基板と空隙層の界面の反射率を高める 目的で、透明導電層を少なくとも一層の高屈折率層とし て含み、最表面層を高屈折率層として高屈折率層と低屈 折率圏を交互に重ね合わせた積層体がコーティングされ

【0021】尚、前配において電極がコーティングされ た基板を用いる場合には、電極面が形成されている側の 基板面が空隙層に接するようにしてセルを作成すること が好ましいが、基板が厚み数ミクロン以下の薄いもので ある場合には必ずしも電極面は空隙層に接していなくと も良い。

【0022】ととで外部電気回路によりセルに適当な直 流電圧を印可した場合には両基板上に異なる極性の電荷 が蓄積されるため基板間に静電引力が発生し、逆に両基 板に同極性の電荷を蓄積させた場合には静電斥力が発生 10 ねることができる。 する結果、前者の場合空隙層の厚みの減少、後者の場合 厚みの増加が発生する。

【0023】尚、前記セルにおいては両電極の短絡防止 の目的で一方もしくは両方の電極上に薄い透明な絶縁層 を形成(図3に例示)したり、絶縁性のスペーサーを分 散すること(図4に例示)も必要に応じて行われる。

【0024】透明絶縁層としては、酸化チタン、チタン 酸バリウム、酸化タンタル等の屈折率の高い金属酸化物 層等が好ましく用いられ、絶縁性のスペーサーとしては 前述の支持構造を形成する材料として例示した各種材料 20 はかかる光変調索子を一次元のアレー状もしくは二次元 のうちで所定の絶縁性を有するものが使用できる。

【0025】また本発明の光変調素子の光変調方法に関 して圧電素子による基板の変位を用いる場合のセル構造 については、例えば図7に示す構造や図8に示す構造等 が挙げられる。前者は、両面に電極層が形成された圧電 性を有する層(以下まとめて圧電駆動部と記す)がセル を構成する一方の基板の片面に形成されており、他方の 基板と圧電駆動部との間に空隙層を有するような構造に なっている。後者は圧電駆動部がセルの支持構造となっ ており、セルの二枚の基板間に空隙層を有する構造であ 30

【0026】両者とも電圧印加時に厚み方向の変位を生 じるような圧電駆動部が用いられ、外部からの電圧印加 により圧電駆動部の厚みを変化させる事により空隙層の 厚みを変化させる事ができる。ことで圧電性を有する層 は、例えばチタン酸バリウム、ニオブ酸リチウム等の無 機系の圧電材料やポリファ化ビニリデン等の有機系の圧 電材料により作成することができる。

【0027】なお圧電駆動部は適当な接着剤を用いて基 は圧電駆動層や接着層の厚みで空隙層の厚みが決定され てしまう事から、場合によっては図8に示すような空隙 層の厚みを最適な値に調整するための層を基板上に設け る等の方法が好ましく用いられる。

【0028】ところで前述の静電気力や圧電変位により 空隙層の厚みの変化を引き起こす方法を用いる場合に は、空隙層の厚みが印加電圧の絶対値に追随して変化す るととから、様々な電圧駆動波形での光変調が可能であ る。

【0029】本発明における光変調索子において、各セ 50 をスクリーン印刷した後、二つの基板がそれぞれの電極

ルを個別に駆動する方法に関しては、単位セルが基本的 にキャパシタンス構造を有していることから、セグメン ト (スタチック) 駆動方式もしくはアクティブマトリク ス駆動方式等の適用が好ましい。

【0030】 ここでセグメント駆動を行う場合には、光 変調駆動に人間の可聴音域未満の周波数の波形(以下光 変調信号と記す)を用い、この駆動波形に可聴音域の周 波数の波形(以下音響信号と記す)を重畳することによ り、本装置は光変調機能と音源としての機能の両方を兼

【0031】ただしこの場合、あらかじめ光変調の1周 期あたりの音響信号の平均実効電圧を算出しておき、そ の電圧値を逆バイアスした光変調信号をかける必要があ る。

【0032】本発明の光変調素子は、該素子を構成する セルを一次元のアレー状もしくは二次元のマトリクス状 に配列して表示部とし、各セルの空隙層の厚みを個別に 変化させ得る上記の如き外的手段を付与して、各種情報 の表示を行う表示装置に利用することができる。あるい のマトリクス状に配列することにより各種情報の表示を 行う表示装置として有用である。

【0033】かかる表示装置は光演算処理装置や光の色 を時間的に変化させることができるカラー照明装置等の 構成部品として、もしくは各種メーターのインジケータ ー、各種コンピューター、携帯情報端末等のモニター等 の用途に好適に用いることができる。

[0034]

【実施例】以下、本発明を更に詳しく説明するために実 施例を記すが、本発明はこの実施例に限定されるもので はなく、当業者であれば容易に類推てきる様々な形態で の実施が可能である。

【0035】なお以下の光学的測定に関しては日立製分 光光度計U-3500の直達透過率測定モードを用いて 行ったものである。

【0036】[実施例1] 0.7mm厚の2枚のガラス 基板上にインジウム/鍋=95:5重量比のITOター ゲットを使用して約30nm厚、面積抵抗約150オー ム/□のITO層をスパッタリングにより形成した。続 板と強く接着させることが好ましいが、これらの構造で 40 いて両基板のITO層上に市販の感光性レジストをスピ ンコーターにより塗布した後、公知の方法を用いてIT O層のパターニングを行い、10mm角の電極部と配線 部からなる3×3の電極バターン(図1に図示)を形成 Lite.

> 【0037】つぎにこの一方の基板上のITO電極部の 周囲に図1に図示したようなパターンで、4ミクロンの 粒径の真球プラスチックピーズ(積水ファインケミカル 社製商品名ミクロバールMP204)を2重量%分散し たエポキシ系樹脂とアミン系硬化触媒からなる樹脂材料

6

部が対向して重なり合うような配置で貼り合わせ、両面を金属板で押さえつけながら80℃で30分の熱処理を行った後、130℃で1時間の熱処理を行い印刷層を硬化させて支持構造を形成し、単位セルが3×3のマトリクス状に配列した透明電極セルを作成した。

【0038】こうして作成した透明電優セルを構成する 一つの単位セルを選択し、その空隙層(空気層)の厚み を光干渉法により測定したところ3.98ミクロンであ った。

【0039】引き続いてとのセルの両電極間化70Vの 10 直流電圧を印可したところ、空隙層の厚みは3.85ミクロンに減少し、セルの光透過スペクトルのバターンが大きく変化した(図10に図示)。尚この時波長550 nmにおける光透過率は電圧無印可時には約67.8%であったが、電圧印可時には約81.0%と大きく変化した。

#### [0040]

【発明の効果】本発明によれば、偏光板を用いない新規な表示装置を供給することが可能となり、本分野の発展に貢献するところ大である。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例に用いた ITO層ならびに支持 構造がパターン状に形成された基板面の模式図である。

【図2】本発明において静電気力を用いるセルの単位構造の一例で、実施例に用いた透明電極セルの単位構造を示す断面模式図である。

【図3】本発明における静電気力を用いるセルの単位構造の一例を示す断面模式図である。

【図4】本発明における静電気力を用いるセルの単位構造の一例を示す断面模式図である。

【図5】本発明における静電気力を用いるセルの単位構\*

\*造の一例を示す断面模式図であり、反射型の画像表示装置に好適なセル構造である。

【図6】本発明において基板表面の反射率を高める場合 に用いられる積層体構造の一例を示す断面模式図であ ス

【図7】本発明における圧電素子を用いたセルの単位構造の一例を示す断面模式図である。

【図8】本発明における圧電素子を用いたセルの単位構造の一例を示す断面模式図である。

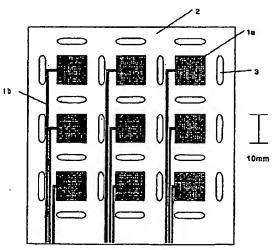
0 【図9】本発明において色フィルターを用いたセルの単位構造の一例を示す断面模式図である。

【図10】本発明の実施例におけるセルの光透過スペクトルバターンである。

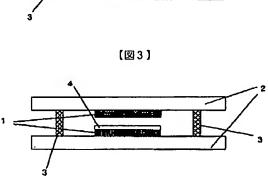
#### 【符号の説明】

- 1 a 透明導電層電極部
- 1 b 透明導電層配線部
- 2 透明基板
- 3 支持構造
- 4 絶縁層
- 20 5 絶縁スペーサー
  - 6 光吸収性を有する基板
  - 7 低屈折率層
  - 8 高屈折率層
  - 9 電極層
  - 10 圧電性を有する層
  - 11 空隙厚み調整層
  - 12 色フィルター
  - 13 70Vの電圧を印加した場合のセルの光透過スペ クトルパターン
  - 14 電圧を印加しない場合のセルの光透過スペクトル パターン

[図1]



[図2]



BEST AVAILABLE COPY

